

KSTAR 중성입자빔 수송라인 해석

임기학 · 김진춘* · 권경훈 · 조승연

기초과학지원연구소, *2621 Crisie Lane, Escondido, California 92025, U.S.A.
(1999년 6월 26일 접수)

An Analysis on the KSTAR neutral beam injection line

K. H. Im, J. Kim,* K. H. Kwon, and S. Y. Cho

Korea Basic Science Institute, *2621 Crisie Lane, Escondido, California 92025, U.S.A.
(Received June 26, 1999)

요 약 – KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) 토카막 핵융합 실험 장치의 플라즈마 가열을 위한 수소 중성입자빔 수송라인 내에 설치되는 빔 스크레이퍼에 가해지는 열속 및 플라즈마에 전달되는 빔의 통과율을 해석하였다. $43\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ 크기의 이온원으로부터 방출되는 이온빔의 공간적 분산(수직 방향으로 1.2° , 수평 방향으로 0.5°)은 이온 가속 전장의 공간적 불균일로 인해 가우스 분산에서 다소 벗어나는 형태를 띠게 되는데, 이러한 비가우스 분산의 영향을 고려할 수 있는 수학적 모델을 정립하였다. 비가우스 분산을 가정할 경우, 이온원에 가장 근접하여 설치되는 스크레이퍼에 가해지는 수직성분의 열속은 9.1 kW/cm^2 였으며, 빔통과율은 28% 정도로 가우스 분산의 경우(약 33%)보다 훨씬 낮은 값을 보였다. 설치상의 오차에 의한 영향도 고려되었는데, 이온원이 1° 기울어졌을 때 스크레이퍼에 가해지는 최대 열속 및 빔통과율은 약 15 kW/cm^2 , 16.6% 정도로 나타나 매우 심각한 결과를 초래함을 알 수 있었다. 이에 비해 스크레이퍼 설치상의 오차의 영향은 이보다 훨씬 작아 5 mm 오차가 발생했을 경우에도 최대 열속은 12 kW/cm^2 였으나, 빔 통과율의 변화는 거의 없었다.

Abstract – The analysis on heat fluxes on and transmission efficiencies by the collimators of neutral beam injection lines in KSTAR tokamak device has been carried out. And a mathematical model describing non-Gaussian beam distribution profile has been established. A neutral beam injection device is composed of 3 separate ion sources and corresponding beam transport lines, which deal with 7.8 MW of beam power, respectively. The divergence angles of ion beam are 1.2° and 0.5° , in vertical and horizontal directions, respectively. The maximum normal heat load on source exit scraper is 9.1 kW/cm^2 and net beam transmission efficiency is ~28%. The effect of misalignment of ion source and scrapers on the scraper heat load and beam transmission also has been analyzed.

1. 서 론

KSTAR 토카막 핵융합 실험 장치에는 수소 플라즈마를 가열하기 위한 보조 가열장치로서 8 MW의 중성입자빔을 플라즈마에 전달하는 수소 중성입자빔 입사(Neutral Beam Injection, NBI) 장치가 설치될 계획으로 있다 [1,2]. 중성입자빔 입사 장치는 3개의 이온원으로 구성되며 각 이온원은 120 kV, 65 A의 용량을 가져 7.8 MW의 출력을 낼 수 있으나, 40% 안팎의 효율을 가지는 중성입자화 과정 및 빔 수송 라인 내의 잔류기체에 의한 재전리 손실 등으로 인해 최종적으로 약 8/3

MW 만이 각 이온원으로부터 플라즈마에 전달되게 된다. 그럼 1에 각 이온원으로부터 토카막에 이르기까지의 빔 수송 라인이 도식적으로 그려져 있으며, 표 1에 그 크기를 나타내었다. $43\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ 크기의 이온원으로부터 방출되는 이온빔은 수직 및 수평 방향으로 각각 1.2° 와 0.5° 의 발산각(divergence)을 갖는 기본적으로는 가우스(Gaussian) 분산의 형태를 가지므로 빔이 진행함에 따라 빔 진행 방향에 대해서 수직 방향으로 빔이 점차 퍼져나가는 성질을 띠게 되는데, 빔 중앙으로부터 많이 벗어난 빔 입자들은 여러 단계에 걸쳐 있는 조준기(collimator)에 의해 점차적으로 제거된다.

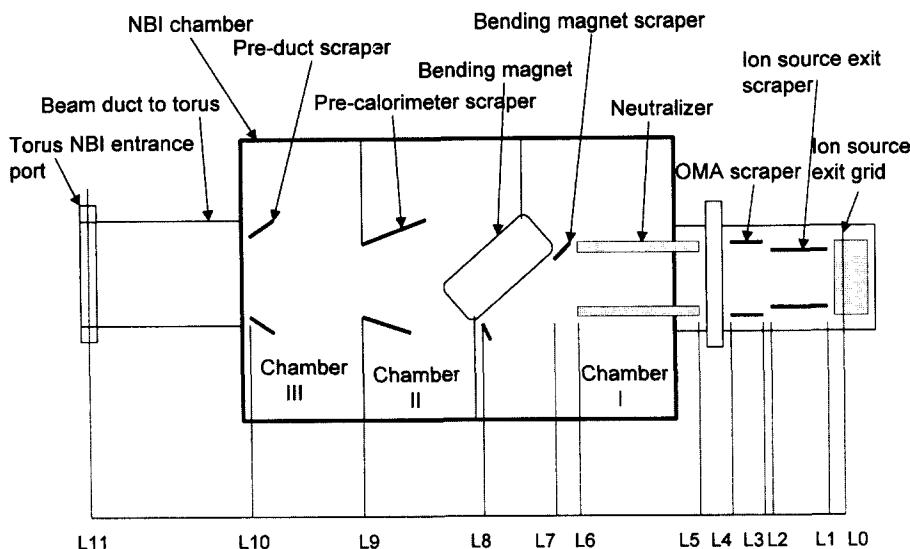


그림 1. KSTAR 중성입자빔 입사장치의 빔라인 구조 (I). 수직 및 수평 방향의 발산각은 1.2° 와 0.5° 이며, 빔 라인 사이의 각도는 4° 이다.

한편, 실제 장치에서 이온 빔의 공간적 분포는, 이온 원에서 생성된 이온들을 가속시키기 위한 가속 전장의 공간적 불균일로 인해 가우스 분산에서 다소 벗어나는 형태를 띠게 되는데, 이 논문에서는 이의 영향을 고려할 수 있는 수학적 모델을 정립하였다 [3].

이 모델에서는 다음과 같은 요소들을 고려하였다. 이온원을 수많은 점원의 집합으로 가정하여 각각의 점원으로부터 주어진 공간적 분산을 가지는 이온들이 방출되는 것으로 가정하였으며, 방출된 이온은 중성화 과정을 거

쳐 40%의 이온만이 중성화되며, 중성화되지 않은 60%의 이온들은 휨 자석(bending magnet)에서 이온 덤프(ion dump)로 유도되어 사라지며, 나머지 중성입자들은 직진 운동을 하게 된다. 빔 진행 도중 빔 중앙에서 크게 벗어나는 일부 중성입자들은 여러 겹으로 존재하는 빔 조준기에 의해 단계적으로 제거되며, 일부 중성입자들은 잔류 수소 기체에 의한 재이온화 [4] 과정을 거치기도 한다.

여기서는 정립된 수학적 모델을 이용하여 이들 조준기에 의해 제거되는 빔의 양 및 재이온화 손실들을 고려하여 최종적으로 플라즈마에 입사되는 중성입자 빔의 효율 및 조준기에 가해지는 수직 성분의 열속을 계산하였다. 또, 빔 수송라인 설치시에 발생할 수 있는 설치 오차를 이온원 설치시의 오차와 빔 조준기 설치상의 오차로 구분하여 이들에 의한 영향도 계산하였다.

표 1. KSTAR 중성입자빔 입사장치의 빔라인 구조 (II)

중앙 빔라인의 크기 (cm)	양 측면 빔라인의 크기 (cm)	구경 (aperture)의 크기 (cm)
L0 0	L0 -19	
L1 24	L1 5	
L2 74	L2 55	source exit 43.0×12.0
L3 75	L3 56	source scraper(exit) 42.2×12.8
L4 120	L4 120	OMA scraper 43.2×14.6
L5 154	L5 154	neutralizer 50.0×15.2
L6 274	L6 274	bending magnet scraper 50.5×15.3
L7 300	L7 300	pre-calorimeter scraper 56.0×22.0
L8 380	L8 380	pre-duct scraper 72.0×72.0
L9 524	L9 524	NBI entrance port 106.0×74.9
L10 677	L10 677	
L11 930	L11 930	

2. 계산 모델

이 장에서는 중성입자빔 입사 장치의 이온원에서 방출되는 빔을 수학적으로 표시하기 위한 모델을 정립해 보기로 한다. 여기에서는 이온원에서 생성된 이온들이 가속 전장의 공간적 불균일로 인해 가우스 분산(그림 2참조)도 기술할 수 있는 모델을 고려한다.

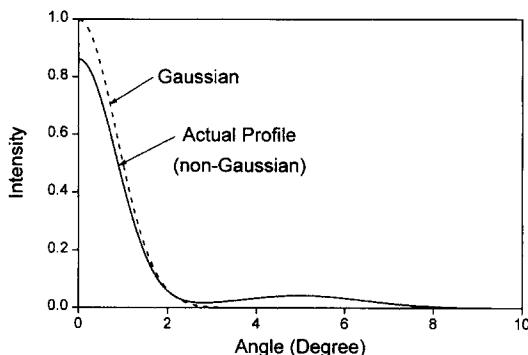


그림 2. 가우스 분포($\theta_x = 1.2^\circ$)를 갖는 빔 요소와 비가우스 분포($\varepsilon_x = 0.05$, $\alpha_x = 5^\circ$, $\omega_x = 2^\circ$)를 갖는 빔요소의 비교. 두 곡선은 밑면적이 같도록 틀맞춤이 되어 있는(normalized) 상태이다.

2.1. 단일 빔 요소의 구조

우선 이온원을, 계산을 위한 여러 개의 요소로 나누 다음에 각 요소에서 방출되는 빔요소(beanlet)의 각분포(angular distribution)를 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$i(\alpha, \beta) = i_0 i(\alpha) i(\beta) \quad (1)$$

여기서, α , β 는 직교좌표계에서 x -, y -방향을 나타내는 각도이고, i_0 는 각 빔요소에 대한 틀맞춤 인자(normalization factor)이며, $i(\alpha)$, $i(\beta)$ 는

$$i(\alpha) = \exp\left[-\frac{\alpha^2}{\theta_x^2}\right] + \varepsilon_x \cdot \exp\left[-\frac{(|\alpha| - \alpha_o)^2}{\omega_x^2}\right] \quad (2)$$

$$i(\beta) = \exp\left[-\frac{\beta^2}{\theta_y^2}\right] + \varepsilon_y \cdot \exp\left[-\frac{(|\beta| - \beta_o)^2}{\omega_y^2}\right] \quad (3)$$

와 같이 표시할 수 있다. 식 (2), (3)에서 첫 항은 발산각(divergence angle) θ_x , θ_y 를 갖는 가우스 분산에 해당하는 항이며, 뒷부분은 가우스 분포에서 벗어난 정도를 기술하는 항이다. ε_x , ε_y 는 비가우스 분산의 상대적인 크기를 나타낸다. α_o , β_o , ω_x , ω_y 각각 x -, y -방향으로의 비가우스 분산의 위치 및 폭을 나타낸다. 틀맞춤 인자 i_0 는 식 (2), (3)을 식 (1)에 대입하여 α , β 에 대해서 각각 $[-\pi/2, \pi/2]$ 범위에서 적분함으로써 구할 수 있다.

$$i_{total} = i_0 \sqrt{\pi} \left\{ \theta_x \operatorname{Erf}\left(\frac{\pi}{2\theta_x}\right) + \varepsilon_x \omega_x \left[\operatorname{Erf}\left(\frac{\alpha_o}{\omega_x}\right) + \operatorname{Erf}\left(\frac{\pi - \alpha_o}{2\omega_x}\right) \right] \right\}$$

$$\cdot \sqrt{\pi} \left\{ \theta_y \operatorname{Erf}\left(\frac{\pi}{2\theta_y}\right) + \varepsilon_y \omega_y \left[\operatorname{Erf}\left(\frac{\beta_o}{\omega_y}\right) + \operatorname{Erf}\left(\frac{\pi - \beta_o}{2\omega_y}\right) \right] \right\} \quad (4)$$

i_{total} 은 각 빔요소의 세기(total intensity)이고, Erf 는 다음과 같이 표시되는 오차 함수(error function)이다.

$$\operatorname{Erf}(\xi) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\xi} e^{-x^2} dx$$

이식들로부터 빔 라인 상의 임의의 지점에서 전체 빔요소에 의한 빔의 세기 분포를 구할 수 있는데, 이를 위해서는 앞 (2), (3)식의 각분포 대신에 아래 식 (5), (6)과 같은 공간적 분포식을 사용하는 것이 더 편리하다.

$$i(x) = \exp\left[-\frac{x^2}{a_x^2}\right] + \varepsilon_x \cdot \exp\left[-\frac{(|x| - x_o)^2}{w_x^2}\right] \quad (5)$$

$$i(y) = \exp\left[-\frac{y^2}{a_y^2}\right] + \varepsilon_y \cdot \exp\left[-\frac{(|y| - y_o)^2}{w_y^2}\right] \quad (6)$$

여기서, z 를 빔 세기 분포를 측정하고자 하는 지점의 빔 진행 방향으로의 위치라 하면, $a_x = z \tan\theta_x$, $x_o = z \tan\alpha_o$, $w_x = z \tan\omega_x$ 와 같은 관계가 성립하고, 식 (1)에서 유추하여, $i(x, y)$ 는 다음과 같이 된다.

$$i(x, y) = i_0 i(x) i(y) \quad (1)'$$

물론, 이 경우에 있어서 틀맞춤 인자 i_0 는 식 (4)와는 다소 다르게 표현된다.

$$i_{total} = i_0 \sqrt{\pi} \left\{ a_x + \varepsilon_x w_x \left[1 + \operatorname{Erf}\left(\frac{x_o}{w_x}\right) \right] \right\} \cdot \sqrt{\pi} \left\{ a_y + \varepsilon_y w_y \left[1 + \operatorname{Erf}\left(\frac{y_o}{w_y}\right) \right] \right\} \quad (7)$$

2.2. 빔통과율

(1)식을 각 빔요소에서 바라다 보이는 각 스크레이퍼(scrapers)의 구경각(aperture acceptance angle)에 대해서 적분함으로써, 각 빔요소가 구경(aperture)을 통과하는 양을 계산할 수 있고, 각 빔요소에 의한 통과량을 합치면 전체 빔에 대한 통과량을 알 수 있다. 그림 3에서처럼, 구경의 크기가 x -방향으로 $[-x_1, x_1]$ 이라 하면, 구경

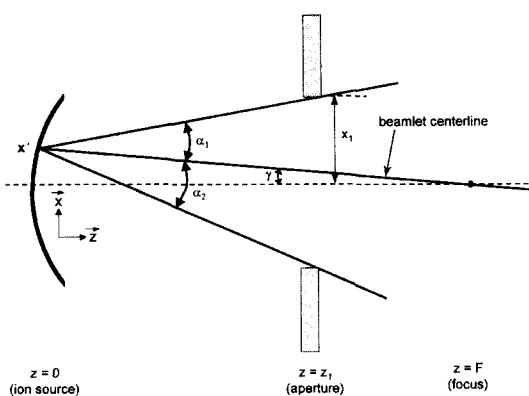


그림 3. 통과율 해석을 위한 기하학적 모델. 이온원 상에서 $x = x'$ 에 위치하는 빔요소에서 발생된 빔 입자들 중 $z = z_1$ 에 위치한 구경을 통과할 수 있는 빔은 $[\alpha_1, \alpha_2]$ 사이에 분포하는 빔입자들 뿐이며, 이 각도를 벗어나는 빔들은 스크레이퍼에 의해 소실된다. 일반적인 경우를 해석할 수 있도록 이온원은 일정한 초점 거리 F 를 가지는 곡면을 가정했으나, KSTAR 중성입자빔 이온원의 초점거리는 무한대 ($F = \infty$)이다.

각은 이온원($z=0$)에서의 빔요소의 위치 x' 에 의해서 정해진다. x -방향으로의 구경각 α_1, α_2 를 구해 보면,

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \tan^{-1} \left(\frac{x_1 + x'}{z_1} \right) - \gamma \\ \alpha_2 &= \tan^{-1} \left(\frac{x_1 - x'}{z_1} \right) + \gamma \\ \gamma &= \tan^{-1} \left(\frac{x'}{F_x} \right)\end{aligned}\quad (8)$$

으로 표현되고, y -방향으로의 구경각 β_1, β_2 도 같은 형태로 표시될 수 있으나, 여기서는 생략한다.

이온원상에서, 점 (x', y') 에 위치한 빔요소의 주어진 구경에 대한 통과율 η' 는 아래 (9) 식으로 표시할 수 있는데,

$$\eta' = \frac{i_o \int_{-\alpha_2}^{\alpha_1} i(\alpha) d\alpha \int_{-\beta_2}^{\beta_1} i(\beta) d\beta}{i_{total}} \quad (9)$$

식 (2)를 이용하여 $\int_{-\alpha_2}^{\alpha_1} i(\alpha) d\alpha$ 를 구해보면,

$$\begin{aligned}\int_{\alpha_2}^{\alpha_1} i(\alpha) d\alpha &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \theta_x \left[\text{Erf} \left(\frac{\alpha_1}{\theta_x} \right) + \text{Erf} \left(\frac{\alpha_2}{\theta_x} \right) \right] \\ &+ \frac{\sqrt{\pi}}{2} \varepsilon_x \omega_x \left[2 \text{Erf} \left(\frac{\alpha_o}{\omega_x} \right) + \text{Erf} \left(\frac{\alpha_1 - \alpha_o}{\omega_x} \right) + \text{Erf} \left(\frac{\alpha_2 - \alpha_o}{\omega_x} \right) \right]\end{aligned}$$

로 되고, $\int_{-\beta_2}^{\beta_1} i(\beta) d\beta$ 역시 동일한 형태로 표시될 수 있다. 각각의 빔요소는 이온원 상에서 하나의 점으로 간주될 수 있으므로, 이온원은 이러한 점들의 집합(예를 들면, $N_x \times N_y$)으로 생각할 수 있고, 따라서, 빔의 총통과율(total beam transmission) η 는 (9)식을 전체 이온원 면적(x', y')에 대해 적분하거나, 혹은 수치적인 합을 구함으로써 구할 수 있다.

$$\eta = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} \eta' \quad (10)$$

그리고, 대개의 경우에 그렇듯이, 여러 개의 조준기가 차별로 존재할 때에는 각 조준기를 통과하는 통과율은 이보다 앞쪽에 존재하는 조준기들에 의한 차폐를 고려해 주어야 한다.

2.3. 빔 세기 분포

이온원 상의 (x', y') 지점에서 $z = F$ 에 위치하는 초점을 가지고 방출된 빔요소에 의한 (x, z) 지점의 빔의 세기는 식 (1)에 x 대신 $x-s$ (그림 4참조)를 대입함으로써 얻을 수 있다. 여기서 $s(x') = x'(1-z/F)$ 로 주어지고, x' 에서 방출된 빔요소에 의한 x 에서의 x -성분 세기는 아래와 같이 표시된다.

$$i(x, x') = \exp \left[-\frac{(x - s(x'))^2}{a_x^2} \right] + \varepsilon_x \cdot \exp \left[-\frac{(|x - s(x')| - x_o)^2}{w_x^2} \right] \quad (11)$$

$i(y, y')$ 도 마찬가지로 쓰여질 수 있다. 계산하고자 하

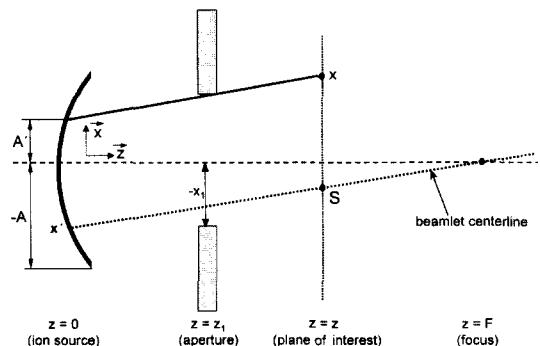


그림 4. 빔 세기 분포 계산을 위한 모델. x 지점에서의 빔 세기는 그보다 이전에 존재하는 구경에 의해 제한을 받는다. 예를 들어, $-A < x' < A'$ 영역에 존재하는 빔요소들만이 x 지점의 빔세기에 영향을 미치며, $x' > A'$ 영역에 위치하는 빔요소들은 x 지점의 빔세기에는 전혀 영향을 미치지 못한다.

는 지점 이전에 존재하는 구경의 영향을 물론 고려하여야 하는데, 그럼 4에서 A' 를 벗어난 곳에서 방출된 빔 요소는 x 지점의 세기에는 영향을 끼치지 않는다. 그럼 4에서 기하학적인 관계식을 유도해 보면,

$$A' = \frac{(zx_1 - z_1x)}{z - z_1}$$

가 성립한다. 따라서 어떤 지점 (x, y) 의 빔세기는 다음 식처럼 영향을 끼치는 모든 빔요소의 기여분들을 모두 합함으로써 구할 수 있다.

$$I(x, y) = i \int_{-A}^{A'} i(x, x') dx' \int_{-B'}^{B'} i(y, y') dy' \quad (12)$$

여기서, A, B 는 각각 x , y -방향으로의 이온원 크기의 절반에 해당하는 길이이다.

2.4. 재전리 손실

중성입자화 셀(neutralizer cell)을 통과한 후의 중성입자들은 빔수송라인 내의 잔류기체와의 충돌로 인해 중성입자가 다시 이온으로 바뀌는 재전리 과정을 거칠 수 있는데, 재전리된 이온들은 플라즈마에 전달되는 중성입자 빔 세기를 감소시킬 뿐만 아니라, 빔 수송 라인 주위에 존재하는 자장에 의해 휘어져 수송 라인의 벽면을 가격하여 열을 가하는 동시에 이온들이 벽면에서 중성입

자로 되어 다시 수송 라인 내로 확산되어 재전리 현상을 더욱 부추기는 악영향도 끼칠 수 있으므로 중요한 고려 요소이다.

이온원에서 방출되는 H^+ , H^{2+} , H^{3+} (중수소의 경우에는 D^+ , D^{2+} , D^{3+})의 비율을 각각 75%, 15%, 10%라고 가정하고서, 빔 진행동안의 재전리 손실율을 계산하였다. 중성입자화 셀은 압력이 3×10^{-3} Torr, 길이가 120 cm로서 셀 내부 기체의 선밀도 (line density)는 $1.27 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$ 가 되며, 중성입자화 셀을 지났을 때 빔을 구성하는 입자들의 에너지 및 구성 비율은 표 2와

표 3. 수소 및 중수소의 에너지별 이온화 반응 단면적 데이터[4]. 어떤 에너지(예를 들면 120 keV)에서의 중수소의 이온화 반응 단면적은 그 절반의 에너지(60 keV)를 가진 수소의 반응 단면적과 같다.

수소 기체의 에너지 (keV)	중수소 기체의 에너지 (keV)	이온화 반응 단면적 (10^{-16} cm^2)
10	20	0.92
20	40	1.3
30	60	1.6
40	80	1.6
60	120	1.5
80	160	1.2
100	200	1.1
120	240	0.95

표 2. 120 keV의 에너지를 가지는 (a) 수소 및 (b) 중수소가 중성입자화 셀을 지난 이후에 보이는 입자의 종류와 해당 에너지[4]. E, E/2, E/3은 각각 이온원에서 방출된 에너지 (120 keV), 1/2에 해당하는 에너지 (60 keV), 1/3에 해당하는 에너지 (40 keV)를 나타낸다..

(a) 수소 120 keV의 경우							
이온원에서 방출된 입자		중성입자화 셀을 지나온 이후의 입자 종류					
종류	비율	$H^0(E)$	$H^+(E)$	$H^0(E/2)$	$H^+(E/2)$	$H^0(E/3)$	$H^+(E/3)$
$H^+(E)$	0.75	0.17	0.83	—	—	—	—
$H^{2+}(E)$	0.15	—	—	0.55	0.45	—	—
$H^{3+}(E)$	0.10	—	—	—	—	0.65	0.35

중성입자화 셀을 거친 후의 $H^0(E) : H^+(E/2) : H^0(E/3) = 46.4\% : 30\% : 23.6\%$							
이온원에서 방출된 입자		중성입자화 셀을 지나온 이후의 입자 종류					
종류	비율	$D^0(E)$	$D^+(E)$	$D^0(E/2)$	$D^+(E/2)$	$D^0(E/3)$	$D^+(E/3)$
$D^+(E)$	0.75	0.4	0.6	—	—	—	—
$D^{2+}(E)$	0.15	—	—	0.72	0.28	—	—
$D^{3+}(E)$	0.10	—	—	—	—	0.82	0.18

표 4. 각 챔버별 압력 및 중성입자 빔을 구성하는 수소 원자의 에너지별 재전리 손실율

	챔버 1	챔버 2	챔버 3	빔덕트
압력 (Torr)	9×10^{-5}	2×10^{-5}	3×10^{-6}	2×10^{-5}
밀도 (cm^{-3})	3.18×10^{12}	7.07×10^{11}	1.06×10^{11}	7.07×10^{11}
길이 (cm)	106	144	153	253
입자종류 (에너지)	재전리 반응 단면적(cm^2)		재전리 손실율	
H_o (E)	9.5×10^{-17}	3.15×10^{-2}	9.63×10^{-3}	1.54×10^{-3}
H_o (E/2)	1.5×10^{-16}	4.93×10^{-2}	1.52×10^{-2}	2.43×10^{-3}
H_o (E/3)	1.6×10^{-16}	5.25×10^{-2}	1.62×10^{-2}	2.59×10^{-3}
D_o (E)	1.5×10^{-16}	4.93×10^{-2}	1.52×10^{-2}	2.43×10^{-3}
D_o (E/2)	1.6×10^{-16}	5.25×10^{-2}	1.62×10^{-2}	2.59×10^{-3}
D_o (E/3)	1.3×10^{-16}	4.29×10^{-2}	1.32×10^{-2}	2.11×10^{-3}

같다[4].

표 3에 보인 재전리 반응 단면적 데이터를 이용하여 빔라인 내의 각 챔버의 압력 및 기하학적 정보로부터 각 챔버를 통과하면서 발생하는 재전리 손실율을 표 4처럼 구할 수 있다. 빔 덕트 부분의 압력은 챔버 중에서 가장 높은 압력인 2×10^{-5} Torr로 가정하였지만, 플라즈마 운전 조건에 따라 변할 수 있는 값이다.

이는 이온원에서 방출되는 7.8 MW의 빔 중에서 플라즈마 내부로 입사되는 중성입자들의 세기가 32.7%인 2.55 MW임을 의미한다. 손실된 67.3%는 이온 덤프에서 51.7% (4.03 MW), 스크레이퍼에서 소실된 양이 10.3% (0.80 MW), 재전리 손실이 5.2% (0.41 MW)였다.

측면 빔 라인의 경우, 빔 효율은 32.3% (2.52 MW)였으며, 각 부분에서의 손실율은 이온 덤프에서 51.0%

3. 해석 결과

3.1. 각 스크레이퍼에 의한 빔손실, 열속 및 빔 통과율

여기서 언급되는 열속은 스크레이퍼가 빔 진행 방향에 수직으로 설치되어 있다고 가정했을 때의 값이며, 실제 장치에서는 빔 진행 방향에 대해 비스듬히 설치될 것이므로, 코사인 함수만큼 감소될 것이다. 프리더트 스크레이퍼 (pre-duct scraper)는 3개의 이온원으로부터 방출되어 나오는 3개의 빔에 공통으로 적용되는 것이므로, 이 스크레이퍼에 미치는 열속은 중앙 빔 라인(central beamline) 및 양 측면 빔 라인(side beam line)에 의한 열속을 합산해 주어야 한다.

그림 5(a), (b)에 가우스 분산 및 비가우스 분산의 경우, 각 스크레이퍼의 상단 및 측면 끝부분에 가해지는 열속을 나타내었다. 최대 열속은 이온원 출구 스크레이퍼(source exit scraper)에서 9 kW/cm^2 이상으로 나타났다.

빔의 공간적 분포에 대해서 가우스 분포를 가정했을 때, 중앙 빔 라인의 경우, 중성입자화 셀 효율을 40%라 할 때, 빔 라인의 효율은 32.7% (2.55 MW)였으며,

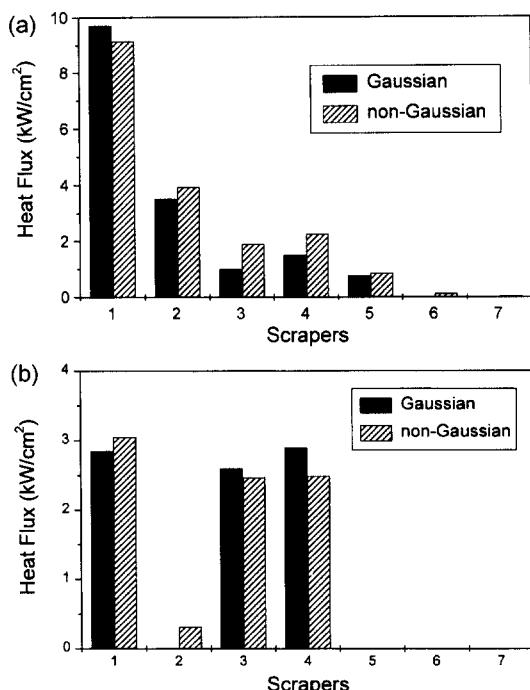


그림 5. 가우스 분산 및 비가우스 분산의 경우, 각 스크레이퍼의 (a) 상단 및 (b) 측면 끝부분에 가해지는 열속.

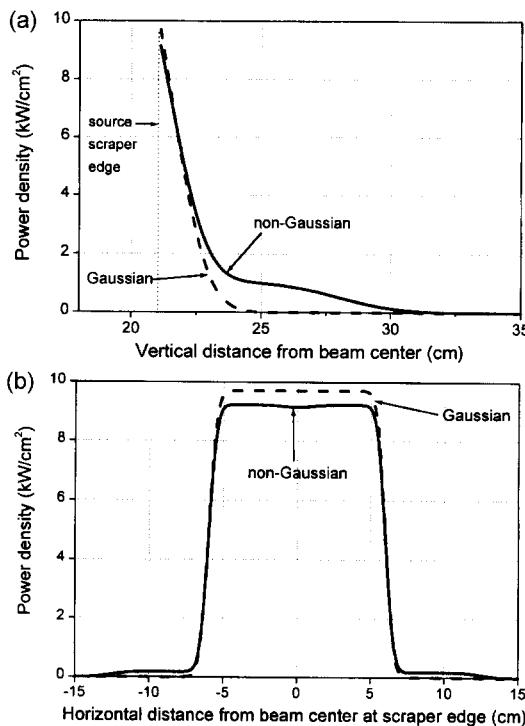


그림 6. 이온원 출구 스크레이퍼의 윗단에 가해지는 빔 파워의 (a) 수직 방향 분포 및 (b) 수평 방향 분포. 비가우스 분포의 경우에 있어서 수평 및 수직 방향의 분포 모두 최고치는 가우스 분포의 경우보다 작으나, 다소 넓게 펴진 분포를 가진다.

(3.98 MW), 스크레이퍼에서 11.5% (0.89 MW), 재전리에 의한 손실이 5.1% (0.40 MW)였다.

한편, 비가우스 분포를 가정할 경우에는 가우스 분포에서 벗어난 정도를 예측하기가 사실상 불가능한 만큼 여기서는 DIII-D 장치의 경우에 해당하는 비가우스 분포($\epsilon_x = 0.05$, $\alpha_{ox} = 5^\circ$, $\omega_x = 2^\circ$, $\epsilon_y = 0.01$, $\alpha_{oy} = 5^\circ$, $\omega_y = 1^\circ$)를 가졌다고 가정하였다. 가우스 분포의 경우보다 스크레이퍼에서의 손실이 약 2.1배 정도 더 많았고, 그에 따라 플라즈마에 전달되는 빔 파워도 중앙 빔 라인의 경우, 27.9% (2.18 MW)로 감소했고, 측면 빔 라인의 경우는 27.6% (2.15 MW)로 감소하였다.

그림 6(a), (b)는 빔 가우스 및 비가우스 분산을 따를 때, 이온원 출구 스크레이퍼의 상단에 가해지는 빔 밀도의 분포를 나타낸다. 비가우스 분포의 경우에 있어서 수평 및 수직 방향의 분포 모두 최고치는 가우스 분포의 경우보다 작으나, 좀 더 넓게 펴진 분포를 가짐을 알 수 있다.

3.2. 설치 오차의 영향

한편, 이온원 및 빔라인을 설치할 때 발생할 수 있는 설치 오차(alignment error)도 플라즈마에 입사되는 빔 파워 및 스크레이퍼에 미치는 열속에 큰 영향을 미칠 수 있는데, 발생 가능한 설치 오차로 이온원의 기울기에 있어서의 오차와 각 스크레이퍼의 위치상의 오차를 생각하여 그 영향을 계산하였다.

우선, 이온원이 수직 및 수평 방향으로부터 기울어진 각도에 따른 영향을 계산해 보았는데, 기울기는 x -, y -방향으로의 기울기를 동시에 고려하였다. 즉, 기울기가 0.5° 라 하면, x -방향과 y -방향으로 각각 0.5° 씩 기울어져 있음을 의미한다. 그림 7에 그 결과를 나타내었는데, 이 계산 결과로부터 아래와 같은 사실들을 알 수 있다.

i) 플라즈마에 입사되는 빔 파워는 설치 오차 각도가 커질수록 계속 감소하여, 기울기가 x -, y -방향으로 각각 1.8° 이상이라면, 플라즈마에 입사되는 파워는 거의 0이 된다. 하나의 이온원으로부터 플라즈마에 입사되어야 할 빔 파워의 목표치는 약 8/3 MW인데, 오차가 0.3%만 되어도 빔 파워는 10% 정도 줄어든다. 비가우스 분산일 때는 빔 파워의 감소가 더욱 심각한 양상을 나타내어, 0.2° 오차에서도 목표치의 20%를 손실하게 된다. 오차가 1.0° 라면, 가우스 분산에서는 목표치의 56%의 빔이, 비가우스 분산에서는 목표치의 48%의 빔만이 플라즈마에 전달되게 된다.

ii) 오차 각도가 1.0° 이상이 되면, 이온원 출구 스크레이퍼의 상단에 가해지는 열속은 14 kW/cm^2 이상으로 거의 최고값에 다다른다.

iii) 측면 끝부분에 가해지는 열속은 오차 각도의 증가

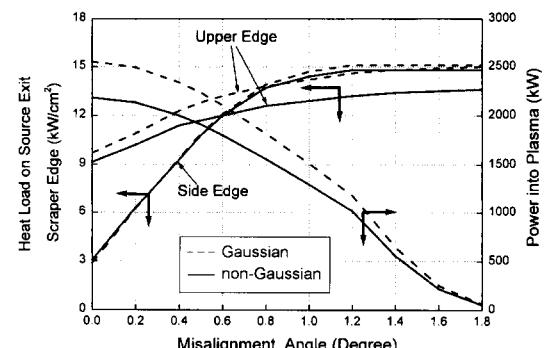


그림 7. 가우스 분산과 비가우스 분산의 경우에 이온원의 설치 오차 정도에 따른 이온원 출구 스크레이퍼의 윗단 및 측면 끝부분에 가해지는 열속과 플라즈마에 전달되는 빔의 세기.

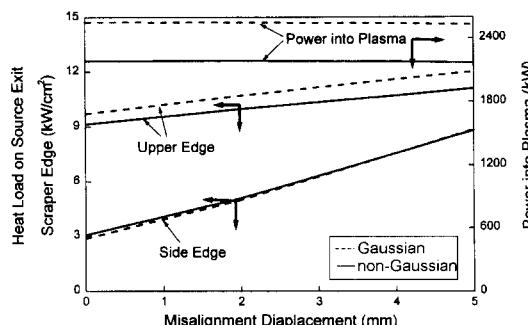


그림 8. 가우스 분산과 비가우스 분산의 경우에 스크레이퍼의 설치 오차에 따른 이온원 출구 스크레이퍼의 윗단 및 측면 끝부분에 가해지는 열속과 플라즈마에 전달되는 빔의 세기.

에 따라 급속히 증가하므로, y -방향으로의 오차가 더 중요하다 할 것이다.

스크레이퍼의 위치상의 오차에 의한 영향도 계산해 보았으며, 그 결과가 그림 8에 나타나 있다. 이 계산에서 오차가 5 mm라 하면 모든 스크레이퍼가 x -, y -방향으로 5 mm씩 같은 방향으로 잘못 설치된 경우를 의미한다. 결론적으로 얘기하면, 5 mm 오차시에도 빔 파워의 손실은 1% 이내였고, 이온원 출구 스크레이퍼의 상단 및 측면 끝부분에 가해지는 열속도 가우스 및 비가우스 분산의 경우에 각각 12.0 kW/cm^2 , 8.9 kW/cm^2 및 11.1 kW/cm^2 , 8.8 kW/cm^2 로 증가하여, 이온원의 설치 오차에 비해보면, 그 영향은 훨씬 덜 심각하다 할 수 있다.

3.3. 플라즈마에 입사되는 빔 밀도의 분포

마지막으로 그림 9(a), (b)에 중앙 빔 라인에 대해서 가우스 분산 및 비가우스 분산의 경우, 플라즈마 내로 전달되는 파워 분포를 3차원 및 2차원 그래프로 나타낸다. 비가우스 분산의 경우 가우스 분산의 경우에 비해 플라즈마로 전달되는 파워가 14% 정도 감소한다는 것을 앞에서 보았는데, 빔 세기의 최고치도 3.44 kW/cm^2 에서 2.88 kW/cm^2 로 15% 정도 감소된 것을 볼 수 있다. 대신 비가우스 분산의 경우 다소 넓게 퍼진 분포를 갖는 것을 알 수 있다. 플라즈마 내로 입사된 중성입자빔 중 일부는 플라즈마를 통과하여 플라즈마 대향 부품 (plasma facing components)의 내벽 및 반대편 벽까지 도달할 수 있는데, 이 해석은 차후에 수행될 예정이다.

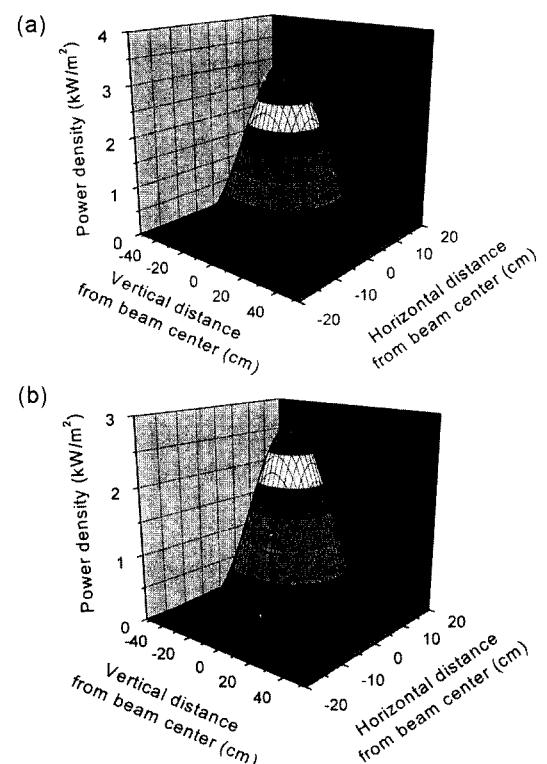


그림 9. 중앙 빔라인에 대한 플라즈마에 전달되는 빔 세기의 3차원 분포. (a) 가우스 분산 및 (b) 비가우스 분산의 경우.

4. 결 론

KSTAR 토틱마 장치의 플라즈마 가열을 위한 수소 중성입자빔 수송라인 내에 설치되는 조준기에 가해지는 열속, 플라즈마에 전달되는 빔의 통과율 및 분포를 해석하였다. 이온원으로부터 방출되는 이온빔의 공간적 분산에 대해서는 가우스 분산과 이온 가속 전장의 공간적 불균일로 인해 발생할 수 있는 비가우스 분산을 고려하였고, 이의 영향을 고려할 수 있는 수학적 모델을 정립하였다.

가우스 분산을 가정하였을 경우, 이온원 출구 스크레이퍼에 가해지는 수직성분의 열속은 9.7 kW/cm^2 로 계산되었다. 이 열속을 제어 가능한 수준으로 낮추기 위해서 조준기는 빔 라인과 거의 나란하게 설치될 것이다. 빔의 통과율은 약 33%로서 하나의 이온원에서 방출된 7.8 MW중 2.5 MW만이 플라즈마에 전달되는 것을 알 수

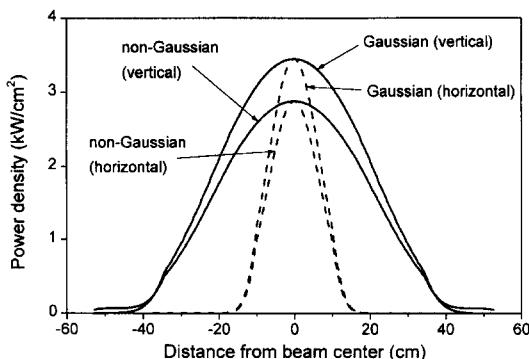


그림 10. 플라즈마에 전달되는 빔 세기의 분포 (중앙 빔라인의 경우). 비가우스 분산의 경우 가우스 분산의 경우에 비해 플라즈마로 전달되는 빔 세기의 최고치가 $3.44 \text{ kW}/\text{cm}^2$ 에서 $2.88 \text{ kW}/\text{cm}^2$ 로 15% 정도 감소된 것을 볼 수 있다.

있었다. 비가우스 분산의 경우, 최대 열속은 $9.1 \text{ kW}/\text{cm}^2$ 로 다소 낮아졌으나, 빔통과율은 28% (2.2 MW) 정도로 더욱 낮아졌다.

설치상의 오차에 의한 영향을 살펴 보면, 이온원이 1°

정도 기울어지게 설치된다면 스크레이퍼에 가해지는 최대 열속 및 빔통과율은 $15 \text{ kW}/\text{cm}^2$, 16.6% (1.3 MW)로 나타나 매우 심각한 결과를 초래함을 알 수 있었다. 이에 비해 조준기 설치상의 오차의 영향은 훨씬 작아 5 mm 오차가 발생했을 경우에도 최대 열속은 $12 \text{ kW}/\text{cm}^2$ 까지 증가했으나, 빔 통과율의 변화는 거의 없음을 알 수 있었다.

참고문헌

- [1] D.I. Choi, et al., Proceedings for the 17th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering, pp. 215-220, San Diego, U.S.A., Oct. 5, 1997.
- [2] KSTAR Project Team, *KSTAR Ancillary Systems Engineering Review Documents*, National Fusion R&D Center, Korea Basic Science Institute, 1998.
- [3] J. Kim and J.H. Whealton, Nucl. Instrum. and Methods **141**, 187 (1977).
- [4] J. Kim and H.H. Haselton, J. of Applied Physics **50**, 3802-3807 (1979).